

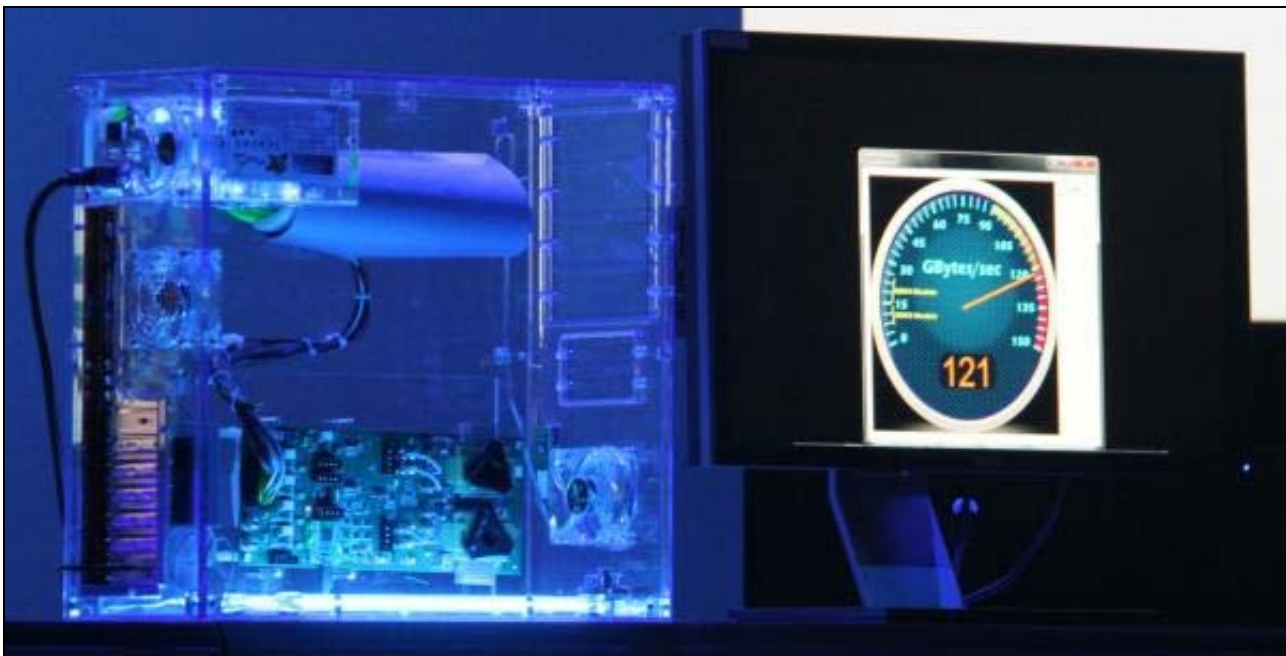
Un consortium pour l'Hybrid Memory Cube

Divers Mémoires

Publié le Mardi 11 Octobre 2011 par Guillaume Louel

URL: </news/11883/consortium-hybrid-memory-cube.html>

Démontrée par Intel et Micron lors de l'IDF, la technologie Hybrid Memory Cube s'ettoffe un peu aujourd'hui avec l'arrivée de Samsung. Micron et Samsung ont en effet annoncé la création d'un consortium dédié à cette technologie dans le but de développer une spécification commune pour l'industrie. Une préversion de la spécification devrait être partagée sous peu par le consortium afin de recueillir suggestions et remarques. La version finale est annoncée pour 2012.



Pour rappel, l'Hybrid Memory Cube consiste à superposer plusieurs die de mémoire DRAM avec un die logique (le processeur). Le prototype présenté lors de l'IDF disposait d'une bande passante de 128 Go/s obtenus avec quatre die DRAM qui communiquent directement avec la couche logique par le biais d'interconnexions qui traversent les die (through-silicon vias).

Copyright © 1997-2012 HardWare.fr. Tous droits réservés.